【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公開番号】特開2002-261062(P2002-261062A)
【公開日】平成14年9月13日(2002.9.13)
【出願番号】特願2001-59776(P2001-59776)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/304　(2006.01)
Ｂ０８Ｂ　3/08　(2006.01)
Ｂ０８Ｂ　3/12　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/308　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/304　６４２Ｂ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６４２Ｅ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６４７Ｚ
Ｂ０８Ｂ　3/08　Ｚ
Ｂ０８Ｂ　3/12　Ａ
Ｈ０１Ｌ　21/308　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月19日(2008.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　第１の洗浄槽内に満たされたオゾンを所定量含有する超純水からなる第１の洗浄液内に半導体ウェハを浸漬して所定時間洗浄する第１の洗浄工程と、第２の洗浄槽内に満たされた水素を所定量含有する超純水からなる第２の洗浄液内に上記半導体ウェハを浸漬して所定時間洗浄する第２の洗浄工程と、を有し、上記第２の工程において上記第２の洗浄液に超音波が供給されている半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項２】　第３の洗浄槽内に満たされた超純水からなる第３の洗浄液内に上記半導体ウェハを浸漬して所定時間洗浄する第３の洗浄工程を上記第１の洗浄工程と上記第２の洗浄工程との間に有する請求項１に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項３】　第４の洗浄槽内に満たされたＨＦ混合液からなる第４の洗浄液内に上記半導体ウェハを浸漬して所定時間洗浄する第４の洗浄工程を上記第２の洗浄工程の後に有する請求項１又は２に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項４】　第５の洗浄槽内に満たされた超純水からなる第５の洗浄液内に上記半導体ウェハを浸漬して所定時間洗浄する第５の洗浄工程を上記第４の洗浄工程の前に有する請求項３に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項５】　上記第１の洗浄液におけるオゾンの溶在濃度が２ｐｐｍ～２０ｐｐｍの範囲にある請求項１、２、３又は４に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項６】　上記第１の洗浄液が１ｐｐｍ～５００ｐｐｍの範囲の溶在濃度の塩酸を含有する請求項１、２、３、４又は５に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項７】　上記第２の洗浄液における水素の溶在濃度が０．３ｐｐｍ～０．８ｐｐｍの範囲にある請求項１、２、３、４、５又は６に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。
【請求項８】　上記第１及び第２の洗浄工程における洗浄時間が３～２０分の範囲にあ

る請求項１、２、３、４、５、６又は７に記載の半導体ウェハ上の粒子を除去する方法。